NT3051

# 2019(Odd)

1640304

Time : 3Hrs. Sem. III/I.C.E. B.E.E.

Full Marks: 70

### Pass Marks : 28

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अक है।

Answer all **Five** questions from **Group B**, each question carries **4** marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all **Five** questions from **Group** C, each question carries 6 marks.

ग्रुप–C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks. दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णीक के सूचक हैं।

1640304	61	ISOETN	ISOELN	7		†030†	<b>'91</b>
6 Write a short notes on any two:		11. Write a short		<b>GROUPA</b>			
	yewe nu	r Internal (i)	gniwollof sht mort r	est suitable answer	om sht seoo	СP	.1
(ii) Stability Factor		(ii) Stability	JX50=20		: suoi	ıdo	
(iii) Varactor diode		(iii) Varactor	: <u>छि</u> न्ति रकम्	ह कि फ़क्की फ्रा	<u>हुम्ह</u> कझी।	<u>6</u> 月	
ਗਿਸਤੀ ਸਾ	श्रीम प्रा कि कि कि कि	म्लिलिन्नि	ces, they have:	ideal current sourc	For the	(i)	
		। <u>क</u> िली	ອວ	o internal resistanc	(a) Zer		
	॥तम्	о <b>р вffø</b> <i>b</i> (i)		v value of voltage	voJ (d)		
	<u> </u>	जेलिमि <del>ऽम</del> (ii)	ţ	ge Value of curren	(c) Lar		
	रुप्रिड	<del>луарур (III)</del>	ance	nite internal resist	ıtın (b)		

(d) Both (b) and (c) (d)

(b) Battery e.m.f.s

(a) Junction currents

मिम कि छिछ किछ (मु)

नाम क वम्फ्स न्मर्न (ब्र)

अंग्रिम क्रीाम्नार प्र्युष्ट (स्)

Kirchoff's voltage law is related to:

ई र्ति अन्त आत्तारिक प्रतिरोध हे (२)

अादश धारा समेस के लिए जनक पास :

(c) IR drops

(11)

(i)

## **OB**(સેજ્ઞવા)

Draw hybrid equivalent circuit for a bipolar Transistor and explain. Also obtain current gain and input impedance.

एक बाइपोलर ट्राजिस्टर के लिए हाईब्रीड समतूल्य परिपथ खींचे तथा उसका वर्णन करें। धारा गेन तथा इनपुट इम्पीडेन्स को मी निकालें।

1640	304 18	NT3051	NT3051	3 1640304
	<b>OR</b> (अथव	r)	(ii)	किरचॉफ का वोल्टेज नियम निम्नलिखित में
	Write down the advantages and	d disadvantage of		से किससे सम्बधित है?
	negative feedback in amplifier			(अ) जंक्शन धारा
				(ब) बैटरी इ.एम.एफ
	ऋणात्मक फीडबैक का एम्प्लीप	नगर के क्षेत्र में लाभ		(स) IR ड्राप
				(द) (ब) तथा (स) दोनों ही से
	तथा हानि को बताएँ।			
			(iii)	A terminal wherethree or more branches
10.	Differentiate between avalanch	ne and zener		meet is known as:
	breakdown effect.			(a) Node
		6		(b) Terminus
	जिनर तथा एवालान्चे ब्रेक डाज	उन प्रभावों में क्या		<ul><li>(c) Combination</li><li>(d) Anode</li></ul>
	अतर है, बताएँ।			(u) Alloue
			(iii)	एक टर्मिनल जहाँ तीन तथा तीन से ज्यादा
	07/	、 、		शाखाएँ मिलते हैकहलाता है।
	OR(अथव	[)		(अ) नोड
				(ब) टर्मिनस
	Describe working of a transiste	or as amplifier.		(स) जोड़(मेलबन्धन)
	Define $\alpha$ and $\beta$ for a transistor	and establish the		(द) एनोड
	relationship between them.			
	-		(iv)	Which of the following is the passive element
	ट्रांजिस्टर का एक एम्ल्पीफायर	के रूप में कार्य		(a) Capacitance
				(b) Ideal current source
	करने का वर्णन करें। ट्राजिस्ट	र हतुα तथा β का		(c) Ideal voltage source

- (c) Ideal voltage source
- (d) All of the above

परिभाषित करें एवं इनके बीच सम्बन्ध स्थापित करें।

क रुगिङ । र्रक त्रशीमप्रीम कि नख्क लम्प्रुजी				
			Я4 (b)	
			(c) 5K	
forward bias and reverse bias of a diode.			(p) 3K/2	
Define P-N junction diode. State and explain			6) R/6	
		ements will be:	The equivalent delta ele	
<b>OB</b> (अल्रचा)		ant of resistance R/2.	A star circuit has eleme	(Λ)
			भिभ में क्राफ्र <i>ए</i> (२)	
ا <del>ک</del> ھ <b>ج</b> اتھ تھ		र्स्	मि र्ण्न्जि मि स्ट्रि (म)	
क पिन्टाईप वधा प्रन–टाईप अर्धचालक पदार्थ के			(ब) आदंश धारा सोसे	
9			म्रन्डमीापर्क (स्ट)	
semiconductor materials.			(म्रक्तार)	
	.8	म्मिर्म <del>उन</del> ्मलीग्र १ <del>१</del> ।	न्रीक मिं में त्रिक्रीजीन्मनी	(vi)
15050791 LI IS05	ELN	ISOETN	<b>†</b>	1640304

- (v) एक स्टार परिपय के एलिमेन्ट का प्रतिगेध (v) है तो इसके समतूल्य ढेल्टा एलिमेन्ट का मान है—
- (q) 4R
   (vi) A close path made by several branches of network is known as:
   (a) Circuit

**(H)** 5K

(d) 3K/7

(H) K/e

A cross para made of several oranteres
(a) Circuit
(b) Loop
(c) Junction
(d) Branch

9

। ग्रैंगिङ ?ई गिर्म हिक फिर्म

। <u>'</u>5 ाशाम्फीम कि हन्धि

emitter follower?

a transistor.

वसकी व्याख्या करें |

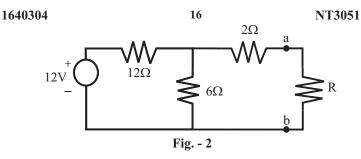
(ब) कॉमन कलेक्टर परिपथ को एमिटर फालोवर

(स) सिकी दायिस्टर में एक्टव क्षेत्र तथा से हुरेशन

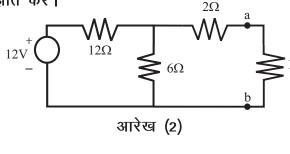
(b) Why common-collector circuit is known as the

9. (a) Define active region and saturation region in

मरवर्ड बायस तथा रिवसे बायस को लिखें तथा



दिए गए आरेख (2) में फेवेनिन समतुल्य नेटवर्क ज्ञात करें।



OR(अथवा)

- (a) Describes Norton's theorem with a suitable circuit
- (b) Explain parallel division of current with a suitable circuit diagram.
- (अ) नार्टन प्रमेय का वर्णन उपयुक्त परिपथ के साथ करें।
- (ब) विद्युत धारा के समान्तयल विभाजन को उपयुक्त परिपथ आरेख द्वारा समझाएँ।

1640304

(vi) एक जाल के अनेक शाखाओं से बने बन्द रास्ते को .....कहते है।
(अ) परिपथ
(ब) लूप
(स) जंक्शन

5

- (द) शाखा
- (vii) The emitter of a BJT is usually dopped heavily because:
  - (a) It is the first region of the transistor.
  - (b) It has to dissipate maximum power
  - (c) It has to dissipate a large number of charge carriers
  - (d) It is of highest resistance
- (vii) एक बी. जे. टी का एमीटर समान्यतया सबसे अधिक डोप्ड होता है, क्योकि–
  - (अ) यह ट्राजिस्टर का पहला प्रदेश है
  - (ब) इसे अधिकतम शक्ति व्यय करना होता है
  - (स) इसे आत्याधिक आवेशित कैरियर आपूक्ति करना होता है
  - (द) यह सबसे ज्यादा प्रतिरोध का होता है
- (viii) In a p-n-p transistor, electrons flow:
  - (a) Out of transistor at the collector and base leads
  - (b) Into transistor at the emitter and base leads
  - (c) Out of transistor at the emitter and base leads
  - (d) Into the transistor at the collector and base leads

					ource	e agetloV (a)	
I	5 मि कि एक म	कम्रह १८५२				in a circuit?	
। रेक नगेष्ठ कि लिगण्य—प्रेगक के र्डायोड लर्न्ड				slement	e following is an active e	which of the	(xi)
		its symbol.			<u>ई</u> ६ि हो	прк Б	
əvig osla & əboib lən	uni to nonsiedo			<del>ऽऽऽ</del> मीं।ऽ	र् भाधार जीडस पर	<u> कहाएम</u> (5)	
ouis colo % choib loo	and fo acitore ac	off aloland		<u></u>	र्ताइ तज्जीविद्य प्रज्ञाव क प्र	<u> ज्र्मली</u> इ	
					र एवं आधार लोडस पर	(स) वत्सजेब	
dT)	OB(સન્ન			2	र्ताइ तडीक्षि प्रसिद्ध कि प्र	<u> उन्नर्ण</u> ारू	
					, एवं आधार लोंडस पर		
। छिलि गिण्ण्ठी सन्नि । सिंहि से सिंहि से सिंह	कर मि एषर्घ क	वेड (LED)		\$ I	र्ताड तडी कि ए रहा के र		
t					. एव <mark>ं</mark> आधार लोडम पर	-	
V	T notes on LED	Write a shor	•9	ॉन	ဒုစ္စနာ ရို အမာစားသူ စပါး		(iiiv)
1940304	51	1508	INLE	ISOETN	9		1040304

evode of the above

(a) N-type material (b) P- type material

—5 пля вире (स) मर्ठ्यात (स) विफ्तीप्र (म) क्रकर्द्र (म) ह्रीायम् (ज्ञ)

(b) Resistance(c) Inductance(d) Capacitance

(x)

(XI)

(c) Both P & N type material

symbol arrow head represents:

In a semiconductor diode schematic

एक्सि में 1877 कुए 115-निकि कि में न्मनी

# **GROUP C**

Answer all Five Questions.

 $0\xi = \xi \times 9$ 

<u>5 रुत्तर के नि</u>ड्र हाँग कि

7. Obtain the Thevenin's equivalent across a-b for the network shown in the figure-2 below.

### O.T.q

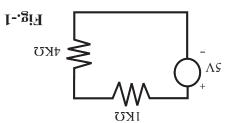
164	0304	14	NT3051	NT3051	7 1640304
4.	Explain semicondu diagram.	ctor action using	g energy band <b>4</b>	(x)	अर्धचालक डायोड में आरेखीय प्रतीक में तीर का निशान प्रदर्शित करता है— (m) N जर्मन प्रपर्श
	ऊर्जा बैण्ड चित्र का का कार्य समझाएँ।	्प्रयोग पर अर्धन OR(अथवा)	वालक पदार्थ		(अ) N-टाईप पदार्थ (ब) P-टाईप पदार्थ (स) दोनों P तथा N टाईप पदार्थ (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
	What is Intrinsic set examples.	miconductor? G	ive suitable	(xi)	Which of the following is not a semiconductor? (a) Ge (b) Si
	इनट्रिनजि्क अर्धचा है? उसका सार्थक		ाप क्या समझते		(c) Mn (d) GaAs
5.	Discuss the need fo	-	4	(xi)	निम्न में से कौन एक अर्धचालक नहीं है? (अ) Ge (ब) Si
	ट्राजिस्टर में वायसि		यों है? समझाएँ		(स) Mn (स) GaAs
OR(अथवा)					
	Explain the basic co amplifiers.	oncept of negativ	ve feedback in	(xii)	A zener diode (a) Has a high forward voltage rating (b) Has a sharp breakdown it low reverse

एम्प्लीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के मुख्य आधार

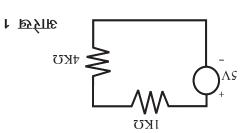
क्या हैं? समझाएँ।

- (b) Has a sharp breakdown it low reverse voltage
  (c) Is see folge on Ampliform
  - (c) Is useful as an Amplifier
  - (d) Has a negative resistance

			ई 155ि र्छर्छि।
	Convert the voltage source in the figure-1 below:		த் ரூழுமை சி
		<b>、</b>	Ťf
	<del>ச</del> ்ச பது கிக்கு நாது (நிற்று கிக்கு கி   சிக்கு கிக்கு கிக்க	<u></u>	ई 1105 म्हाइ
	Explain the star-delta transformation in brief.	1	ात्रि ग <sup>5</sup> र्थ चेत्री होत
	ОВ(अन्नवा)		
1	13 194030	SOETN	ISOETN



कि मिसि एउंगे में वेल्ले मिस प्रमित्त के बदले



**O**B(સેજ્ઞવા)

Define and explain Thevenin's theorem.

धिम प्रमेय क प्रमामित क रेंतथा उसका कि

ן <u>ל</u>אס הלטק

- 1640304 8 NT30 (ixi) एक जेनर डायोड— (ख्र) के पास तब्दा फारवर्ड वोल्टेज रेटिंग होत है (ख्र) के पास तीक्ष्ण केकडाउन होता है, (ख्र) एम्प्लीफायर के रूप में उपयोगी है (त) के पास उक्ष्णात्मक प्रतिशोध होता है
- (ح) के पास ऋणात्मक प्रतिरोध होता हे
   (a) PIN diodes are also known as:
   (a) PIN diodes
   (b) Hot carrier diodes
   (c) Step-recovery diodes

səpoib lənnuT (b)

- (iiii) शॉर्ट्की डायोड को यह भी कहा जाता है– (अ) पिन डायोड (स) स्टेप-रिकावरी डायोड (द) टनेल डायोड
- (xiv) LEDs are made out of :
  (a) Silicon
  (b) Germanium
  (c) Gallium
  (d) Silicon and Germanium, but not gallium

7

1640304	12	NT3051	NT3051	9 16403	04
(xx)	एक N-P-N ट्रांजिस्टर में होती है— (अ) >I <sub>E</sub> (ब) <i<sub>E (स) ≅I<sub>E</sub> (स) <math>\cong</math>I<sub>E</sub> (द) <math>\frac{1}{2I_E}</math>I<sub>E</sub></i<sub>	संग्राहक धारा	(xiv)	लेड बने होते है– (अ) सिलिकॉन (ब) जर्मेनियम (स) गैलियम से (द) सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का परन्तु गैलियम का नहीं	
			(xv)	<ul> <li>A tunnel diode is used:</li> <li>(a) In high power circuits</li> <li>(b) In circuits requiring negative resistance</li> <li>(c) In very fast -switching circuits</li> <li>(d) In power supply rectifiers.</li> </ul>	Э
			(xv)	टनेल डायोड का उपयोग होता है— (अ) उच्च—पावर परिपथ में (ब) ऋणात्मक प्रतिरोध का जरूरत हो वैसे परिपथ में।	1
	GROUP B	}		(स) तीव्र गति के स्वीचिंग परिपथ में	
	all <b>Five</b> Questions.	$4 \ge 5 = 20$		(द) रेक्टिफायर के पावर —सप्लाई में	
2. Sate	। प्रश्नों के उत्तर दें and explain Kirchoff's law चॉफ नियमों को विघुत परि उसका वर्णन करें।	4	(xvi)	<ul> <li>When negative voltage feedback is applied to an amplifier, its voltage gain</li></ul>	1
				DT	0

**P.T.O** 

$\frac{1}{2}I_{E}$	))	evolution of the above (b)	
I - I	·)	(c) Amplifiers	
∃I≌ (3	)	(b) Rectifiers	
${}^{\mathrm{E}}$ I > (0	)	(a) Oscillators	
$_{\rm B}$ I< (b	2)	Negative feedback is employed in:	(iiivx)
n an N-P-N transistor collect current is:	I (xx)		
		<u> </u>	
क्र) शाहकी	.)	(स) मिमव गेन	
म्रुकर्ट्ह (म	<u>.</u> )	(ब) प्रतिवाधा मिलान	
ब) जिनर	.)	(अ) धारा गुन	
भ्राभ्य (भ्र	<b>)</b>	—ई 1DTM	
्रे मिरक थिक में कार्य होर	8	трकी грина тарият и по	(iivx)
क प्रकार मकी ,ई काओर भि Va मा	±.		
क ाठिज्जीव नग्रह के के स्वी के	$\overline{\boldsymbol{\nu}}$ (xix)	shore of the above $(d)$	
		(c) Voltage gain	
d) Schottky		(b) Impedance matching	
c) Varacter	,	(a) Current gain	
o) Zener		Emitter follower circuit is used for:	(iivx)
a) Avalanche	·		
coner diodes with breakdown voltages greater an 5V operates in which type of breakdown		हिम ट्रेकि मि मिलरियट (इ)	
retreen sepetion antohyterd dim schoil reno?	$\nabla$ (viv)	(स) अत्रार्यस्वा दे	
121. 214 12 4 1240 (5	)	(ब) घटया ई	
द) राजप्रायः (१२) इम्रायम् में स्रि		(अ) बढ़ता ई	
भूषा (मूल्यू) (मूल्यू) (मूल्यू) (मूल्यू) (मूल्यू) (मूल्यू)	-	वोल्टेज गेन भ	
(२१२१४) २२१२७११ (२ १११२७२७) (१	[	क्षित्र होते हैं ति किया जाता है, ति इसका स्व स्टर्स्ट	
अ) ओसिलेटर (दोलित्र)	-		(14.2)
–தீ மதே முடி மை கிதரே குடியால	$\simeq$ ( $\prod x$ )	व्यब कोई तम्स्लीफायर में ऋणात्मक विभव	(ivx)
11 1940304	ISOETN	150ELN 01	1640304